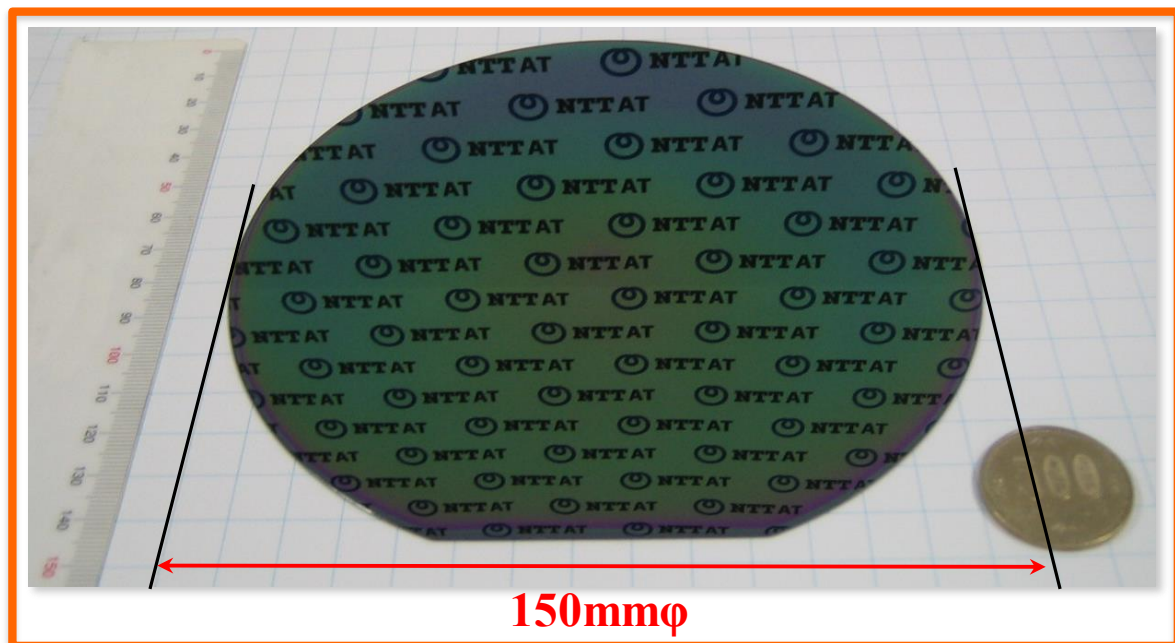
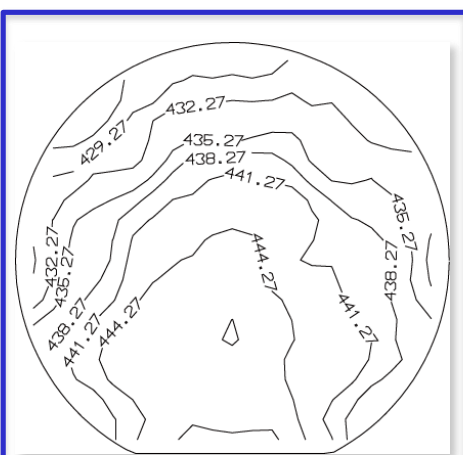


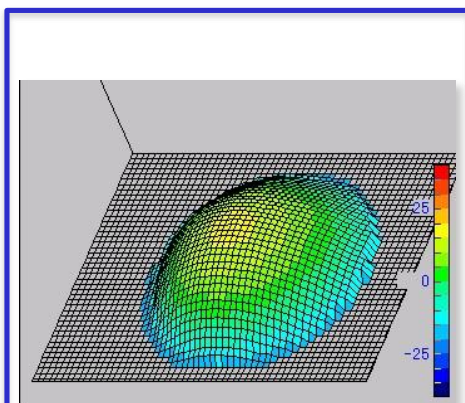
# 6インチSi基板上AlGa<sub>N</sub>/Ga<sub>N</sub> HEMT



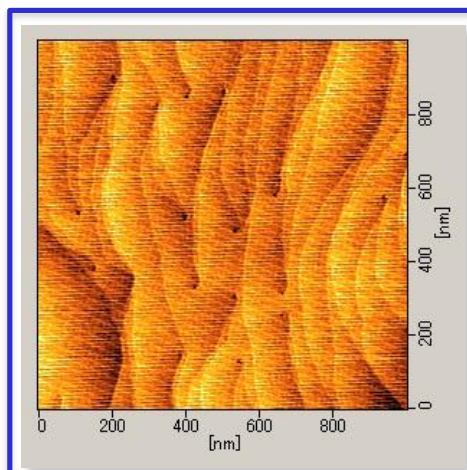
次世代パワーデバイスとして期待されている窒化物半導体。低コストでの量産化へ向けには、大口径Si基板上での高品質な窒化物エピタキシャルウエハが求められています。NTT-ATなら6インチSi基板上エピタキシャルウエハの品質も安心です。



シート抵抗分布 : Variation 6%  
Ave.: 440 ohm/sq.  
Mobility: 2180 cm<sup>2</sup>/Vs)



ウエハ形状 : 160μm以上の曲率半径  
BOW: 34 μm  
SORI: 34 μm



表面粗さ : RMS ~0.25 nm (1μm視野)  
表面欠陥密度 : ~2e9 cm<sup>-2</sup>

※本カタログ記載の内容は予告なく変更されることがあります。また、記載されている数値等は測定例での値であり、本製品の保証値ではありません。

●お問い合わせ先

NTTアドバンステクノロジー株式会社

<http://www.keytech.ntt-at.co.jp/>

グローバル事業本部 プロダクトインキュベーションセンタ

〒243-0124 神奈川県厚木市森の里若宮3-1 NTT厚木研究開発センタ内

TEL : 046-250-3682 FAX : 046-250-3871